

## 製品概要

### NCP5104: シングル入力ハイサイドおよびローサイド Power MOSFET ドライバ

技術情報は、データシートをご参照ください。

NCP5104 は、高圧電源ゲートドライバで、2つのNチャネル・パワー MOSFET または IGBT を直接駆動する出力が2つあり、ハーフブリッジ構成になっています。ブートストラップ技術を利用し、ハイ・サイド電源スイッチの適正な駆動を保証します。

#### 特長

- High Voltage range: up to 600 V
  - dV/dt Immunity 50 V/nsec
  - Gate drive supply range from 10 V to 20 V
  - High and Low drive outputs
  - Output source / sink current capability: 250 mA / 500 mA
  - 3.3 V and 5 V input logic compatible
  - Up to Vcc swing on input pins
  - Under Vcc LockOut (UVLO) for both channels
  - Pin to pin compatible with Industry standard
  - Matched propagation delays between both channels
- For more features, see the data sheet

#### 利点

- Rugged and flexible design
- Robust design
- Wide supply range
- Suitable for half bridge converter topology
- Suitable for low to mid power applications
- Low level input for micro-controller operation
- Flexible input level up to Vcc
- Robust design
- Reduced design efforts

#### アプリケーション

- Half bridge power converter: low to mid power

#### 最終製品

- Lighting ballast
- White goods
- Motor Control

#### 電氣的仕様

製品	Pricing (\$/Unit)	Compliance	Status	Power Switch	Number of Outputs	Topology	Isolation Type	V <sub>in</sub> Max (V)	V <sub>cc</sub> Max (V)	Rise Time (ns)	Fall Time (ns)	Drive Source Current Typ (A)	Drive Sink Current Typ (A)	Turn On Prop. Delay Typ (ns)	Turn Off Prop. Delay Typ (ns)	Delay Matching	Package Type
NCP5104DR2G	0.4267	Pb-free Halide free non AEC-Q and PPAP	Active	MOS FET / IGBT	2	Half-Bridge	Junction Isolation	600	20	85	35	0.25	0.5	620	100	45	SOIC-8
NCV5104DR2G	1.0466	AEC Qualified PPAP Capable Pb-free Halide free	Active	MOS FET / IGBT	2	Half-Bridge	Junction Isolation	600	20	85	35	0.25	0.5	620	100	45	SOIC-8

# アプリケーション・ダイアグラム

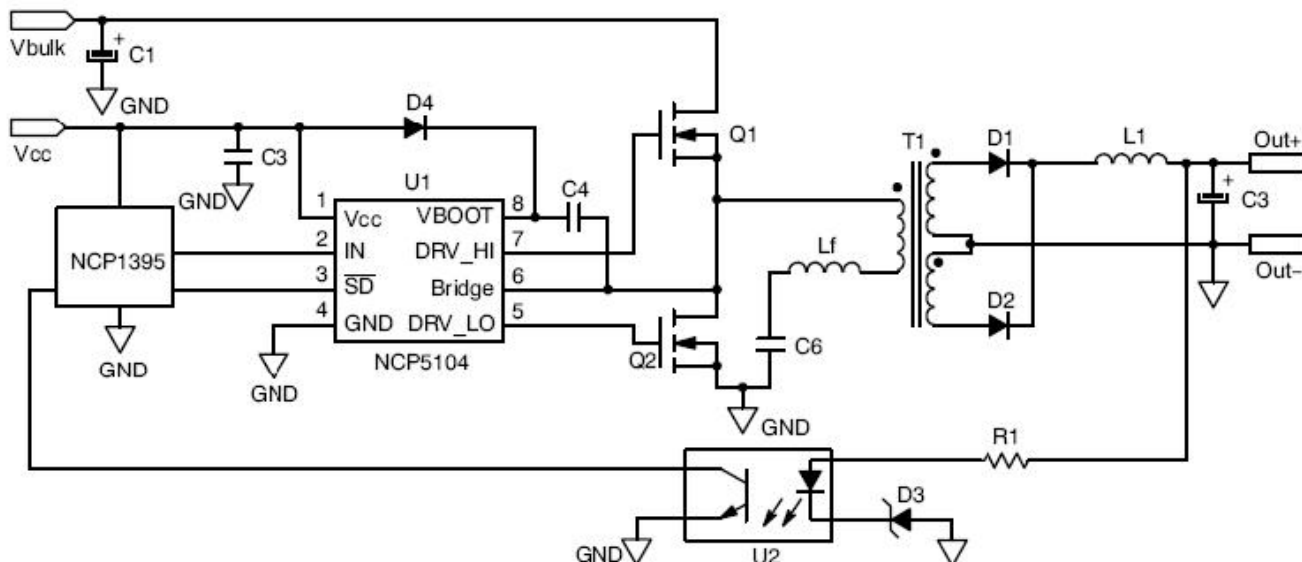


Figure 1. Typical Application Resonant Converter (LLC type)

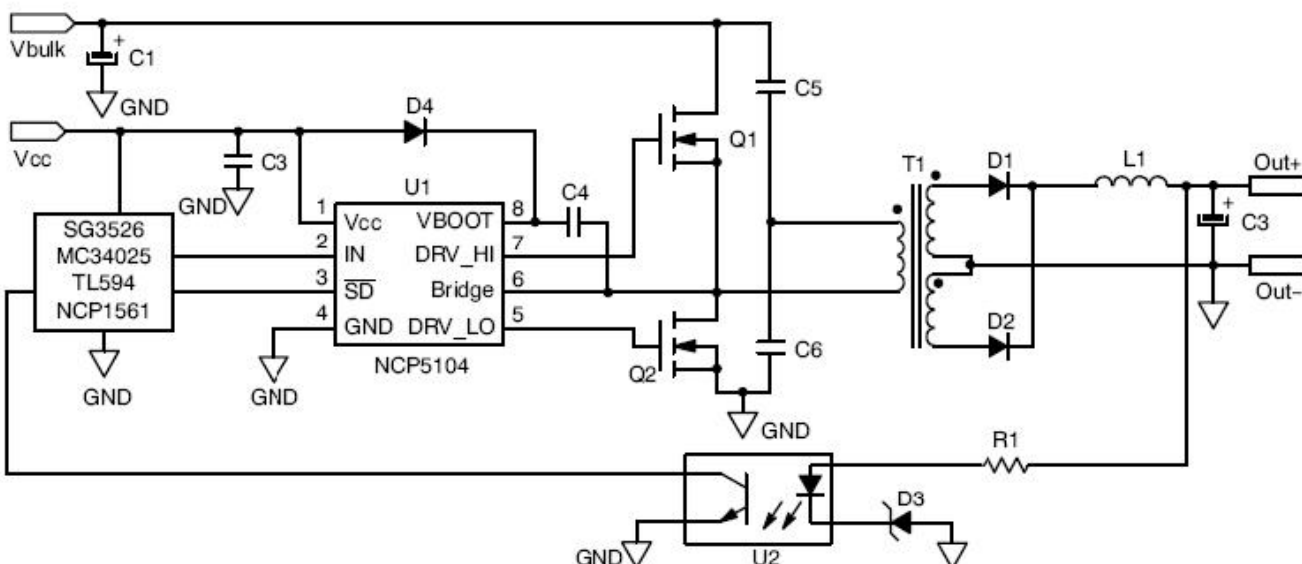


Figure 2. Typical Application Half Bridge Converter

詳細は、弊社 [www.onsemi.jp](http://www.onsemi.jp) の営業または販売代理店にお問い合わせください。

6/22/2021 作成